

# Diode Modules

Circuit configuration:Half-Bridge

ITEM	$V_{RRM}$	$I_F(AV)$	$I_{FSM}$	$I^2t$	$I_{RRM}$	$V_{FM}/I_{FM}$	$V_{FO}$	$r_F$	$R_{th(j-c)}$	$R_{th(c-h)}$	T <sub>jm</sub>	Viso	Out Line No.
CONDITION	150°C	100°C	10ms		150°C	25°C	150°C	per chip					
UNIT	V	A	kA	kA <sup>2</sup> s	mA	V/A	V	m·Ω	°C/W		°C	V(AC)	
MD70D**S	800-1,800	70	1.9	18.1	8	1.45/210	0.80	2.50	0.57	0.20	125	3,000	M16
MD90D**S	800-1,800	90	2.0	20	8	1.50/270	0.80	1.70	0.47	0.20	125	3,000	M16
MD110D**S	800-1,800	110	2.0	24.2	8	1.55/330	0.80	1.74	0.35	0.20	125	3,000	M16
MD135D**S	800-1,800	135	3.8	72.2	12	1.45/410	0.85	1.35	0.22	0.080	125	3,000	M17
MD160D**S	800-1,800	160	4.0	80	12	1.50/480	0.85	1.25	0.20	0.080	125	3,000	M17
MD182D**S	800-1,800	182	4.0	84.1	12	1.55/550	0.83	1.20	0.19	0.080	125	3,000	M17
MD200D**S	800-1,800	200	4.0	92.5	12	1.60/600	0.78	1.10	0.18	0.080	125	3,000	M17

Circuit configuration:Single

ITEM	$V_{RRM}$	$I_F(AV)$	$I_{FSM}$	$I^2t$	$I_{RRM}$	$V_{FM}/I_{FM}$	$V_{FO}$	$r_F$	$R_{th(j-c)}$	$R_{th(c-h)}$	T <sub>jm</sub>	Viso	Out Line No.
CONDITION	150°C	100°C	10ms		150°C	25°C	150°C	per chip					
UNIT	V	A	kA	kA <sup>2</sup> s	mA	V/A	V	m·Ω	°C/W		°C	V(AC)	
MH70D**S	800-1,800	70	1.9	18.1	8	1.45/210	0.8	2.5	0.57	0.20	125	3,000	M16
MH90D**S	800-1,800	90	2	20	8	1.50/270	0.8	1.7	0.47	0.20	125	3,000	M16
MH110D**S	800-1,800	110	2.2	24.2	12	1.45/410	0.8	1.74	0.35	0.20	125	3,000	M16
MH135D**S	800-1,800	135	3.8	72.2	12	1.45/410	0.85	1.35	0.22	0.080	125	3,000	M17
MH160D**S	800-1,800	160	4	80	12	1.50/480	0.83	1.2	0.19	0.080	125	3,000	M17
MH182D**S	800-1,800	182	4.1	84.1	12	1.60/550	0.78	0.1	0.18	0.080	125	3,000	M17
MH200D**S	800-1,800	200	4.3	92.5	12	1.60/600	0.78	1.1	0.18	0.080	125	3,000	M17